








	<h2 style="color: red;">BSZ160N10NS3GATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ160N10NS3GATMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BSZ160N10NS3GATMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5600 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ160N10NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 12µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta), 40A (Tc)

BSZ160N10NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ160N10NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ160N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ160N10NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ16DN25NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>	 <p>BSZ165N04NSG INF BSZ165N04NSG INF</p>	 <p>BSZ15DC02KD H INFINEO INFINEO TSDSON-8</p>	 <p>BSZ165N04NS G Infineon Technologies BSZ165N04NS G Infineon Technologies</p>
 <p>BSZ160N10NS3 G INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSZ165N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 31A TSDSON- 8</p>	 <p>BSZ15DC02KD HXTMA1 Infineon Technologies MOSFET N/P-CH 20V 8TSDSON</p>	 <p>BSZ160N10NS3G INFINEO BSZ160N10NS3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ160N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ160N10NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ160N10NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ160N10NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ160N10NS3GATMA1
BSZ160N10NS3GATMA1 Electronic	BSZ160N10NS3GATMA1-Komponenten	BSZ160N10NS3GATMA1-Verteiler	BSZ160N10NS3GATMA1-Bild	BSZ160N10NS3GATMA1-Teil
BSZ160N10NS3GATMA1 Preis	BSZ160N10NS3GATMA1 Hersteller	BSZ160N10NS3GATMA1 Bild	BSZ160N10NS3GATMA1 Aktie	BSZ160N10NS3GATMA1 Inventar
BSZ160N10NS3GATMA1 Neu	BSZ160N10NS3GATMA1 Original	BSZ160N10NS3GATMA1 garantiert	BSZ160N10NS3GATMA1 RFQ	BSZ160N10NS3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited